

Содержание

Поздняков А.О., Богданов А.А., Возняковский А.П.

Термо- и фотоиндуцированное взаимодействие компонентов композита поли-*n*-бутилметакрилат–фуллерен C₆₀ 1

Вакулин Д.А.

Метод определения угла преднаклона директора в ячейках с гибридной и гомеотропной ориентацией нематического жидкого кристалла 7

Кудряшов Д.А., Гудовских А.С., Можаров А.М., Большаков А.Д., Мухин И.С., Алфёров Ж.И.

Моделирование характеристик двухпереходных солнечных элементов на основе гетероструктур ZnSiP₂ на кремниевой подложке 15

Кузнецов В.В., Сафонов С.А., Шамирзаев А.С.

Особенности кипения и конденсации при восходящем течении в мини-канальных системах 24

Рембеза С.И., Свистова Т.В., Кошелева Н.Н., Овсянников С.В., Аль Тамеми В.М.К.

Влияние оптического излучения на адсорбционные процессы взаимодействия газов-восстановителей с пленкой SnO₂ 32

Гембаржевский Г.В., Леднев А.К., Осипенко К.Ю.

Моделирование эволюции плазменного следа пары цилиндров под действием электрического разряда 40

Дубровский В.Г.

Модель селективного роста III–V нитевидных нанокристаллов 49

Котов О.И., Чапало И.Е.

Локализация внешнего воздействия в распределенном межмодовом волоконном интерферометре 54

Лебедев А.А., Бер Б.Я., Богданова Е.В., Середова Н.В., Казанцев Д.Ю., Козловский В.В.

О связи радиационно-стимулированной фотолюминесценции с атомами азота в p -4H-SiC 61

Барышников А.С., Басаргин И.В., Бобашев С.В., Монахов Н.А., Попов П.А., Сахаров В.А., Чистякова М.В.

Экспериментальное исследование взаимодействия летящих тел с пламенами 68

Бадарин А.А., Куркин С.А., Короновский А.А., Храмов А.Е.

Исследование влияния проводимости стенок камеры дрейфа на динамику релятивистского электронного потока с виртуальным катодом 72

Орловский В.М., Панарин В.А., Шулепов М.А.

Изменение воды, водных растворов и диэлектрических пленок в диффузном разряде, формируемом предыонизацией быстрыми электронами при коротком фронте импульса напряжения 81

Лебедев А.А., Давыдов С.Ю., Сорокин Л.М., Шахов Л.В.

Получение квазисверхрешеток на границе эпитаксиального слоя 3C-SiC и подложек гексагональных политипов SiC методом сублимационной эпитаксии в вакууме 89